

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ
(PCT方式)(ダーリントン接続)

2SB1024

- スイッチング用
- ハンマードライブ用, パルスモータードライブ用
- 電力増幅用

特 長

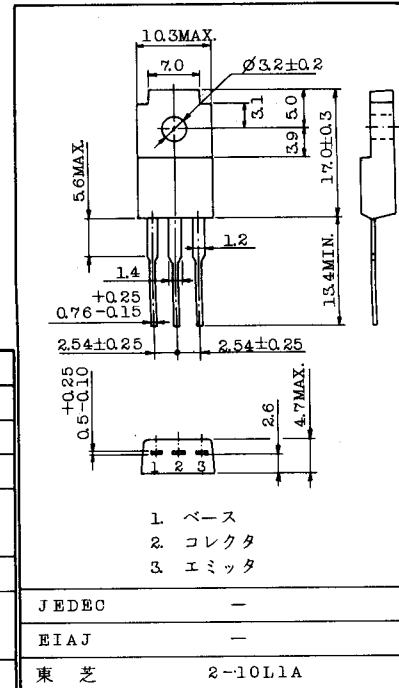
- ・ 直流電流増幅率が高い。
: $h_{FE}=2000$ (最小) ($V_{CE}=-2V$, $I_C=-1A$)
- ・ 飽和電圧が低い。: $V_{CE(sat)}=-1.5V$ (最大) ($I_C=-3A$)
- ・ 2SD1414とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

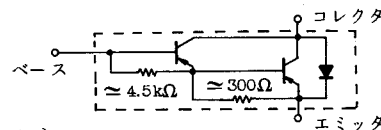
項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	DC	I_C	A
	パルス	I_{CP}	
ベース電流	I_B	-0.3	A
コレクタ損失	$T_a=25^\circ C$	P_C	W
	$T_c=25^\circ C$		
接 合 温 度	T_j	150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

通信工業用

単位: mm



等価回路



電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-100V$, $I_E=0$	—	—	-20	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V$, $I_C=0$	—	—	-2.5	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10mA$, $I_B=0$	-80	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-1A$	2000	—	—	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-2V$, $I_C=-3A$	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-3A$, $I_B=-6mA$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-3A$, $I_B=-6mA$	—	—	-2.0	V
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	—	0.15	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}	—	0.80	—	
	下降時間	t_f	—	0.40	—	